レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡を用いた SiC フォトダイオードのテラヘルツ波放射の波長依存性評価

Evaluation of Wavelength Dependence of THz Emission from SiC Photodiode

Using a Laser Terahertz Emission Microscope

SCREEN¹, 阪大レーザー研² ⁰西村 辰彦¹, 中西 英俊¹, 北村 藤和¹, 水端 稔¹ 川山 巌², 斗内 政吉²

SCREEN¹, ILE Osaka Univ.², ^oT. Nishimura¹, H. Nakanishi¹, F. Kitamura¹, M. Mizubata¹

I. Kawayama², M. Tonouchi²

E-mail: tat.nishimura@screen.co.jp

レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡(Laser Terahertz Emission Microscope: LTEM)は、試料から放 射される THz 波を検出・イメージ化することで、p-n 接合、絶縁膜/半導体界面、半導体表面などの材料界 面の電場/キャリアダイナミクスなどの情報分析を 可能とする技術である[1]。我々は、これまで LTEM 技術を太陽電池、Si パッシベーション膜、GaN ウエ ハ・LED、4H-SiC ウエハ・熱酸化膜評価に適用し、 その可能性を示してきた[2-4]。今回、励起光波長を 変化させ、SiC フォトダイオードの分析を行った。

LTEM システム構成を図1に示す。Ti:サファイヤ レーザーの第三高調波(波長 280 nm、光量3 mW、 ビーム径 50 µm)、第二高調波(波長 400 nm、光量 120 mW、ビーム径 50 µm)、及び基本波(波長 700 nm、 光量 240 mW、ビーム径 7 µm)を試料に45 度で照射 した。放射された THz 波を放物面鏡により集光し、 スパイラル型 LT-GaAs 光伝導素子で検出した。試料 は、市販の4H-SiC フォトダイオード(ピーク感度波 長 280 nm)を開封し、逆バイアス電圧 10 V を印加 して計測を行った。図2 に試料のデータシート記載 の写真と分光感度特性を示す。

図3に試料の受光部中心から放射されたTHz 波の時間波形を示す。入射光強度が異なるため一概には 議論できないが、波長400 nm 及び700 nm 励起のTHz 波ピーク強度は、280 nm 励起と比較して相対的にそ れぞれ約1/100、1/200程度であり、試料の分光感度 特性と関連があると考えられる。試料受光部の光学 像を図4(a)に示す。灰色の矩形は電極である。図4(b), (c)は、光学像の赤枠部のLTEMイメージ(750 µm 角、 51 x 51 pixels)である。(c)励起波長400 nm では電極の 右上(点1)と左下(点2)付近でTHz 波振幅強度 (絶対値)が高い。点1,2 のTHz 波形が反転してい ることから電流の向きが異なることが示唆される。

励起波長を変化させて計測することで、LTEMが、²²⁰⁰ 感度の異なる領域でのフォトダイオードのキャリア¹⁰⁰ の振る舞いの分析に適用できる可能性を示した。 References

1) 斗内, 応用物理, 84, 1101 (2015).

Mochizuki, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **110**, 163502 (2017).
Sakai, *et.al.*, APL Photonics **2**, 041304 (2017).
中西, 他, 第 64 回応物春季予稿集, 17a-301-1 (2017).



Fig.1 Schematic of the experimental set up.



Fig.2 Optical image and normalized spectral responsibily of the analyzed SiC-PD.



Fig.3 THz wave forms from the sample.



(a) Optical image.

(a) Optical image.

(b) LTEM image excited at 280 nm.(c) LTEM image excited at 400 nm.

© 2017年 応用物理学会